



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7 :

H01L 27/12, 21/84

A1

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/46858

(43) Date de publication internationale: 10 août 2000 (10.08.00)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR00/00268

(22) Date de dépôt international: 4 février 2000 (04.02.00)

(30) Données relatives à la priorité:
99/01369 5 février 1999 (05.02.99)

FR

(81) Etats désignés: JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): COMMIS-SARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (US seulement): PELLOIE, Jean-Luc [FR/FR]; 83, rue Roger Dumarais, Villa N°7, F-38430 Moirans (FR).

(74) Mandataire: WEBER, Etienne; Brevatome, 3, rue Du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

(54) Titre: MOS TRANSISTOR WITH DYNAMIC THRESHOLD VOLTAGE EQUIPPED WITH A CURRENT LIMITING DEVICE AND METHOD FOR MAKING SAME

(54) Titre: TRANSISTOR MOS A TENSION DE SEUIL DYNAMIQUE EQUIPE D'UN LIMITEUR DE COURANT, ET PROCEDE DE REALISATION D'UN TEL TRANSISTOR

(57) Abstract

The invention concerns a semiconductor device comprising on a substrate: a first MOS transistor (10) with dynamic threshold voltage, with a gate (116), and a channel having one first type of conductivity, and a current limiting element (20) connected between said first transistor gate and channel. The invention is characterised in that said first transistor is provided with a first zone (160) doped with the first type of conductivity, connected to the channel, and the current limiting element comprises a second zone (124) doped with a second type of conductivity and electrically connected to the first zone by an ohmic connection. The invention is useful for producing CMOS circuits.

